



GEM

Groupe c
de la Matière Con

TRAITEMENTS PRÉ ET POST-CROISSANCE

Four de recuit haute température

Modèle : Elite Thermal Systems TSH16/50/180

Recuit jusqu'à 1600°C sous flux d'azote dédié au diamant semiconducteur.



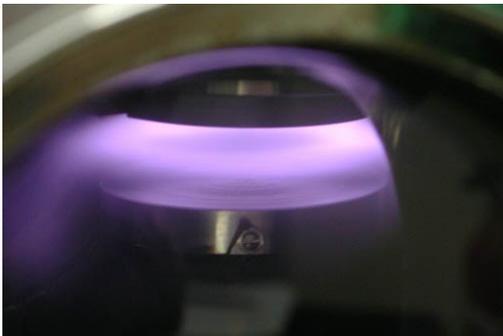
Hydrogénation / Deutération par plasma capacitif RF 13.56 MHz

Pour semiconducteurs III-V, II-VI

Modèle : réacteur MECA2000

Conditions : 1 Torr, 25 - 500°C

Echantillon soit dans le plasma, soit en aval du plasma (remote)



Hydrogénation / Deutération par plasma micro-ondes 1.45 GHz

Pour le diamant

Modèle : réacteur Materia utilisé pour la croissance diamant

Conditions : 10-20 Torr, 450 - 1000°C

